



G60070G

70W, 28V GaN 射频功率晶体管

Oct 15 2024



Product datasheet.V1.0

概要描述

G60070G 是一款功率 70W，28V 内匹配设计的 GaN 射频功率晶体管，专为频率高达 4GHz 的多种应用而设计。它可以支持饱和条件下的连续波、脉冲或其他回退条件下的调制信号的应用。在 0.5-3GHz 或 0.1-0.5GHz 的典型宽带应用中，它能在整个频带内以更高的效率和增益提供超过 50W 的功率。当应用于其他频率时，无法保证其性能。

典型应用性能

测试条件：Vds = 28V，Vgs=-2.41V，Idq = 390mA，信号模式：CW

测试 500-3000MHz 的典型宽带性能，焊接装配（推荐驱动 ML33012）

Freq (MHz)	Psat (dBm)	Psat (W)	IDS (A)	Pin (dBm)	Gain (dB)	Eff (%)
500	47.38	54.7	4.11	35.10	12.28	47.53
600	48.52	71.1	4.75	37.00	11.52	53.47
700	48.94	78.3	4.64	38.27	10.67	60.30
800	48.91	77.8	4.00	38.05	10.86	69.47
900	48.40	69.2	3.41	37.53	10.87	72.46
1000	48.07	64.1	3.37	37.37	10.70	67.95
1100	48.10	64.6	3.54	36.72	11.38	65.14
1200	48.42	69.5	4.10	37.80	10.62	60.54
1300	48.32	67.9	3.81	37.47	10.85	63.67
1400	47.78	60.0	3.39	36.90	10.88	63.19
1500	47.47	55.8	3.35	36.82	10.65	59.54
1600	48.64	73.1	4.33	37.93	10.71	60.31
1700	48.79	75.7	4.37	37.74	11.05	61.85
1800	48.79	75.7	4.40	35.85	12.94	61.43
1900	48.53	71.3	4.10	35.82	12.71	62.10

G60070G

70W, 28V GaN 射频功率晶体管

Freq (MHz)	Psat (dBm)	Psat (W)	IDS (A)	Pin (dBm)	Gain (dB)	Eff (%)
2000	47.86	61.1	3.79	36.87	10.99	57.57
2100	47.65	58.2	3.83	37.29	10.36	54.28
2200	47.75	59.6	4.09	37.30	10.45	52.01
2300	47.60	57.5	4.03	37.04	10.56	51.00
2400	47.79	60.1	4.19	36.50	11.29	51.24
2500	47.88	61.4	4.17	36.72	11.16	52.57
2600	47.90	61.7	4.13	37.10	10.80	53.32
2700	47.60	57.5	4.00	37.37	10.23	51.38
2800	47.78	60.0	4.19	36.52	11.26	51.12
2900	48.08	64.3	4.26	36.54	11.54	53.88
3000	47.79	60.1	3.89	37.30	10.49	55.19

测试条件: $V_{ds} = 28V$, $V_{gs} = -2.52V$, $I_{dq} = 120mA$, 信号模式: CW

测试 100-500MHz 的典型性能, 焊接装配 (推荐驱动 L40001P)

Freq (MHz)	Psat (dBm)	Psat (W)	IDS (A)	Pin (dBm)	Gain (dB)	Eff (%)	2 nd (dBc)	3 rd (dBc)
100	48.90	77.6	3.74	27.82	21.08	74.13	-9.20	-13.30
150	47.60	57.5	2.68	26.85	20.75	76.68	-13.40	-16.70
200	48.30	67.6	3.05	27.95	20.35	79.17	-13.80	-14.20
250	47.75	59.6	2.68	28.72	19.03	79.38	-10.20	-18.00
300	48.23	66.5	4.05	28.83	19.40	58.67	-14.00	-15.00
350	48.71	74.3	3.59	26.85	21.86	73.92	19.30	-33.50
400	48.56	71.8	3.64	27.46	21.10	70.43	-24.70	-46.00
450	49.32	85.5	4.37	28.57	20.75	69.88	-17.70	-46.00
500	48.41	69.3	3.99	27.88	20.53	62.07	-25.00	-31.00

产品特点

- 提供出色的效率和线性化能力；
- 耐热增强型工业标准封装；
- 采用高可靠性金属化工艺；
- 优异的热稳定性以及坚固性；
- 适用于无线通信基础设施，宽带放大器、EMC 测试、ISM 等；
- 符合有害物质限制（RoHS）指令 2002/95/EC 无铅。

加电顺序

打开设备

- 1、将 V_{GS} 加至 -5V
- 2、将 V_{DS} 打开至额定工作电压(28V)
- 3、增加 V_{GS} ，直到出现 I_{DS} ，表明晶体管开启
- 4、打开驱动，输入功率

关闭设备

- 1、先关闭驱动
- 2、将 V_{DS} 降低至 -5V，过程中 I_{DS} 逐渐降低至 0 mA
- 3、将 V_{DS} 降低至 0 V
- 4、关闭 V_{GS}

典型参数说明

表 1. 热特性参数

参数	符号	值	单位
热阻（管芯封装至法兰） 测试条件： $T_C=85^{\circ}\text{C}$, $T_J=200^{\circ}\text{C}$, DC Power Dissipation	$R_{\theta JC}$	1.6	$^{\circ}\text{C}/\text{W}$

注意： $R_{\theta(JC-DC)}$ 仅在直流条件下进行测试，与所有测试条件中的最高热阻值有关。在不同的射频操作条件下，如 CW、pulse 等信号，可能会有不同程度地降低。

表 2. 极限参数

参数	符号	值	单位
漏极电压	V_{DSS}	150	Vdc
栅极电压	V_{GS}	-10,+2	Vdc
工作电压	V_{DD}	40	Vdc
最大正向栅极电流	I_{gmX}	16	mA
储存温度范围	T_{stg}	-65 to +150	°C
封装工作温度	T_C	+150	°C
工作结温	T_J	+225	°C

注意：在最高结温下连续运行将影响 MTTF。

表 3. 电学特性参数(TC=25°, 除非特殊注明)

直流特性					
参数及符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
$V_{(BR)DSS}$ --击穿电压	$V_{GS}=-8V$ 、 $I_{DS}=16mA$	150			V
$V_{GS(th)}$ --开启电压	$V_{DS}=28V$ 、 $I_D=16mA$	-4	-	-2	V
$V_{GS(Q)}$ --栅极静态电压	$V_{DS}=28V$ 、 $I_{DS}=400mA$		-2.4		V

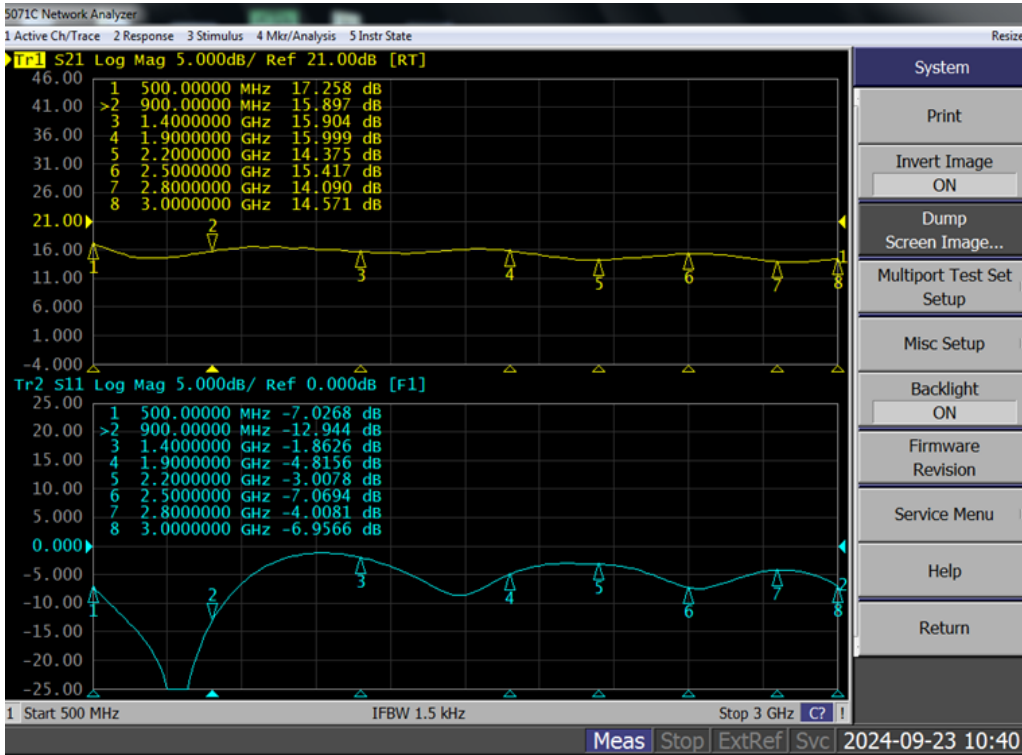
注意： $V_{GS(Q)}$ --栅极静态电压：数据来源于典型应用测试。

典型测试曲线与版图

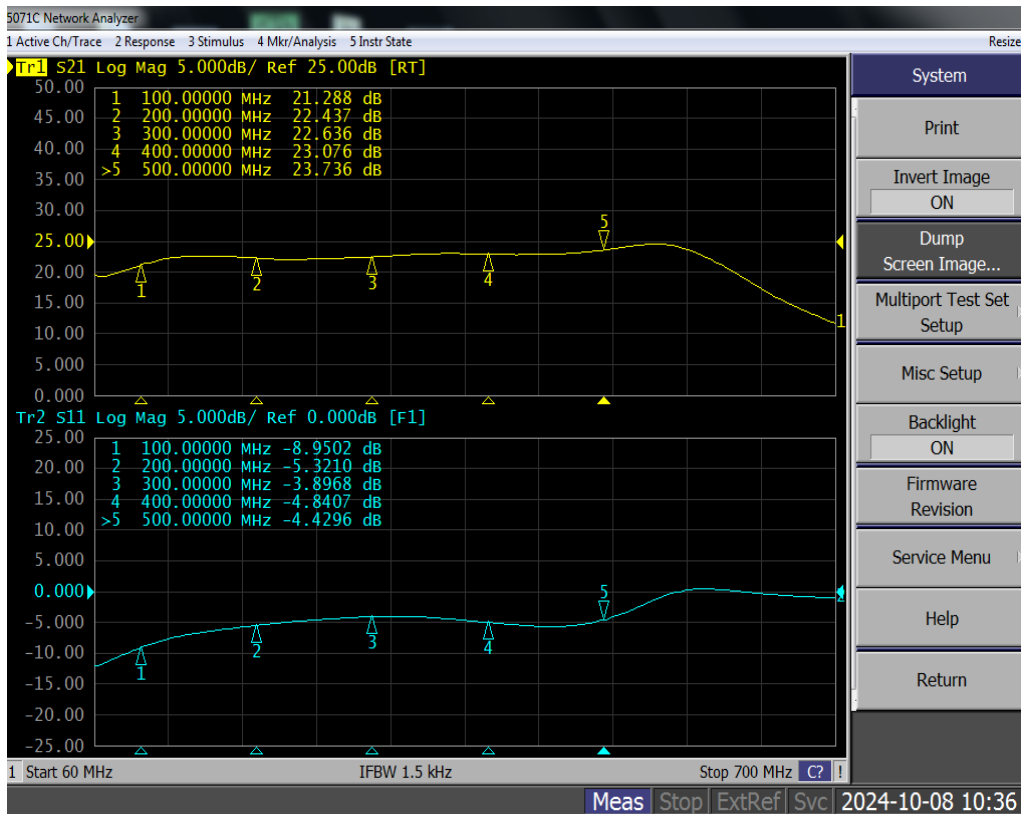
小信号测试性能

I：测试条件： $V_{gs}=-2.43V$ ， $V_{ds}=28V$ ， $I_{dq}=350mA$ ；Input Power=0dBm

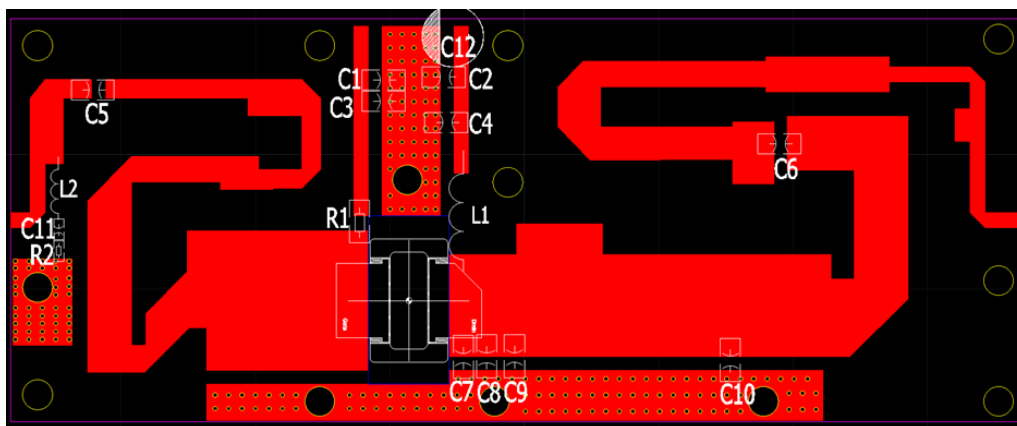
测试频段：500-3000MHz



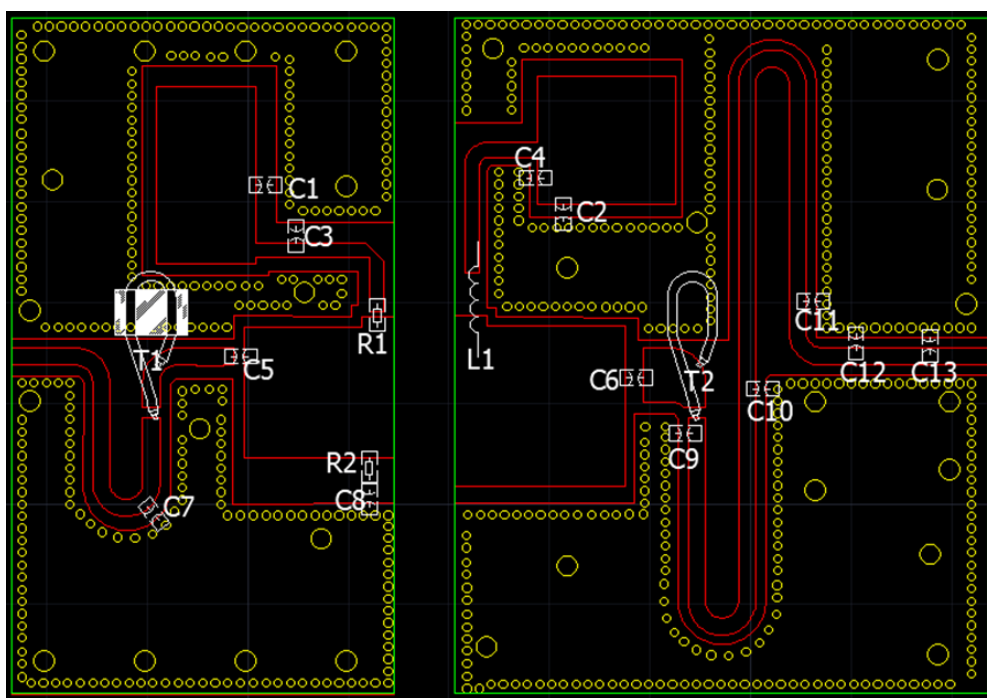
II：测试条件：Vgs=-2.52V，Vds=28V，Idq=120mA；Input Power=-10dBm
测试频段：100-500MHz



测试版图



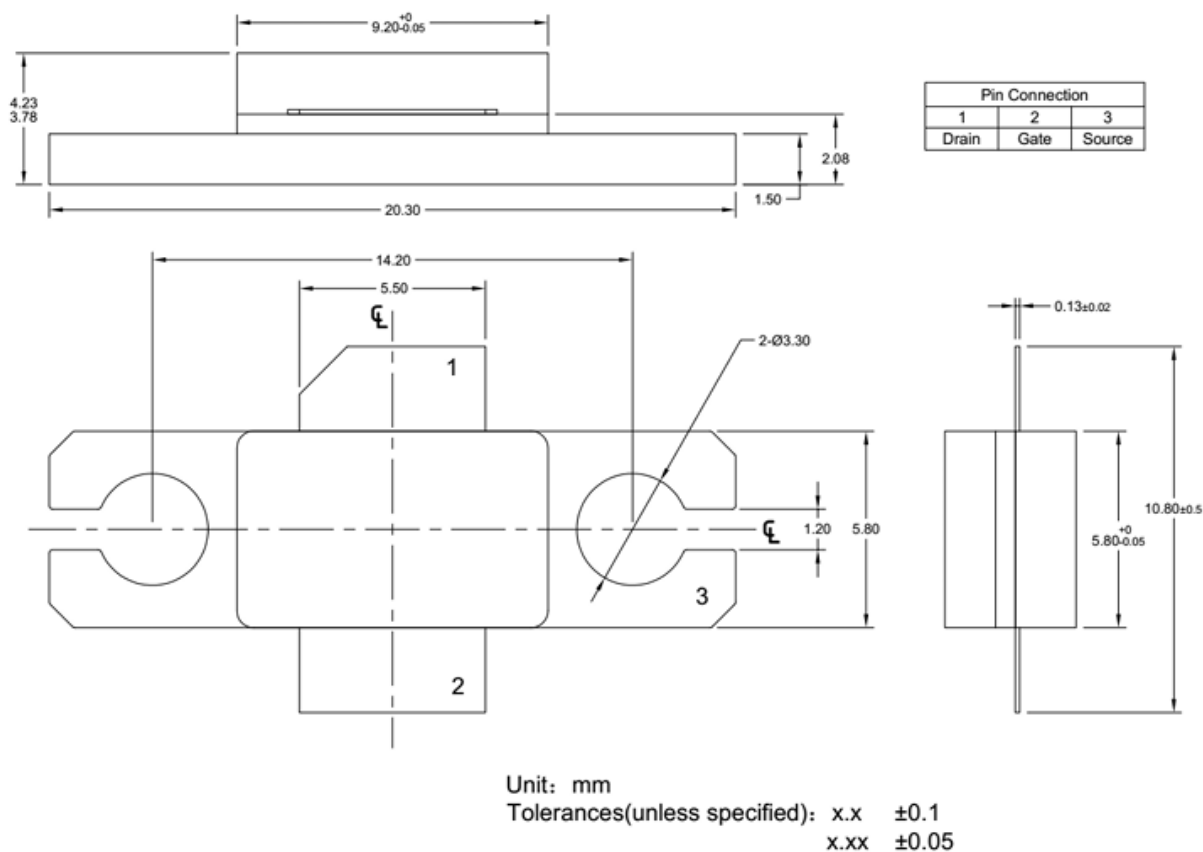
频段 500-3000MHz (20 Mil Rogers 4350)



频段 100-500MHz (30 Mil Rogers 4350)

更多测试数据具体见测试报告。

封装尺寸图



注意：所有尺寸均以毫米（mm）为单位。

版本修订记录

日期	版本	修订说明	备注
2024-10-15	1.0	发布初版数据手册	

注意事项

- （1）本说明书中的内容，随着产品的改进，有可能不经过预告而更改。请客户及时到本公司网站下载更新 <http://www.rfwatt.com/>。
- （2）请注意输入电压、输出电压、负载电流的使用条件，使 PA 内的功耗不超过封装的容许功耗。更多频段测试数据请参考相应测试报告。